

### 关键指标

频率: DC~18GHz  
插入损耗: 1dB  
隔离度: 40dB  
电源电压: -5V  
控制电平: 0/+5V  
芯片尺寸: 1 mm×1.14mm×0.1mm

### 产品简介

HG126KB 是一款 DC~18GHz 反射式单刀双掷开关芯片, 采用 GaAs pHEMT 工艺制作, 插入损耗为 1dB, 隔离度为 40dB。

### 电性能 (T<sub>A</sub>=25°C, V<sub>dd</sub>=-5V)

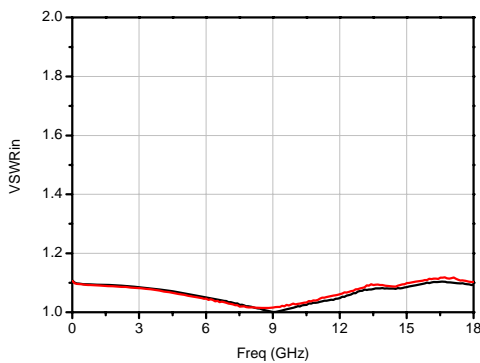
指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	DC~18		
插入损耗(dB)	-	1	-
隔离度(dB)	-	40	-
输入驻波	-	1.2	-
输出驻波	-	1.2	-

### 真值表 (0: 0V, 1: +5V)

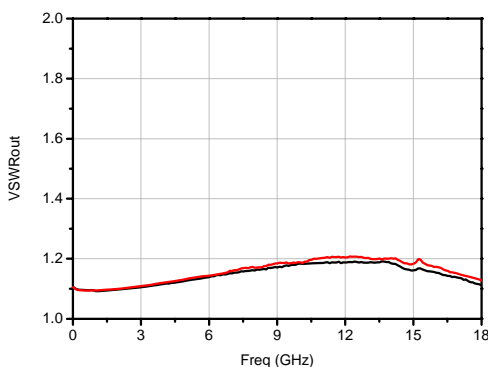
SW	RFC to RF1	RFC to RF2
0	ON	OFF
1	OFF	ON

### 典型测试曲线

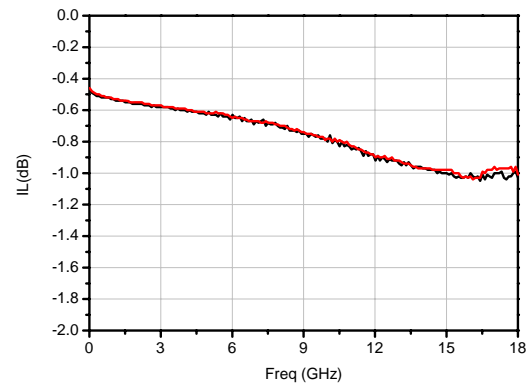
输入驻波



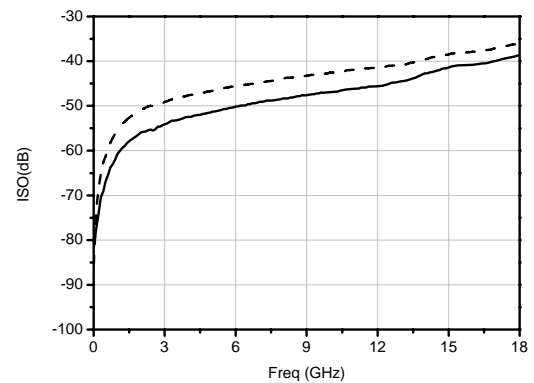
输出驻波



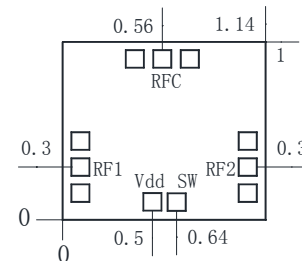
插入损耗



隔离度



### 外形和端口尺寸 (mm)



### 绝对额定最大值

最大输入功率	+27dBm	
工作电压	-5.5V	
控制电压	低电平: 0~0.5V	高电平: 3.7~5V
工作温度	-55°C~125°C	
存储温度	-65°C~150°C	

### 注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储, 在超净环境使用;
2. GaAs 材料较脆, 不能触碰芯片表面, 使用时必须小心;
3. 芯片用导电胶或合金烧结 (合金温度不能超过 300°C, 时间不能超过 30 秒), 使之充分接地;
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm, 使用 Φ25μm 双金丝键合, 建议金丝长度 250~400μm;
5. 芯片微波端无隔直电容;
6. 芯片对静电敏感, 在储存和使用过程中注意防静电。